PRESSEINFORMATION

Infineon stärkt Position als führender Integrated Device Manufacturer (IDM) im GaN-Markt mit 300-Millimeter-Fertigung nach Plan

München – 2. Juli 2025 – Um der steigenden Nachfrage nach Galliumnitrid-(GaN)-Halbleitern zu begegnen und von diesem Trend zu profitieren, stärkt die Infineon Technologies AG ihre Position als führender Integrated Device Manufacturer (IDM) im GaN-Markt weiter. Heute gab das Unternehmen bekannt, dass seine Umsetzung der skalierbaren GaN-Fertigung auf 300-Millimeter-Wafern im Zeitplan liegt. Mit ersten Samples, die Kunden im 4. Quartal 2025 zur Verfügung stehen, ist Infineon in einer starken Position, um seine Kundenbasis zu erweitern und seinen Status als führendes GaN-Powerhouse weiter zu festigen.

Als Marktführer im Bereich Leistungselektronik beherrscht Infineon alle drei relevanten Materialien: Silizium (Si), Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid. Durch höhere Leistungsdichte, schnellere Schaltzeiten und geringere Leistungsverluste ermöglichen GaN-Halbleiter kleinere Designs und reduzieren den Energieverbrauch sowie die Wärmeentwicklung in elektronischen Geräten wie Smartphone-Ladegeräten, Industrie- und Humanoiden Robotern oder Solarwechselrichtern.

„Mit einer vollständig hochskalierten 300-Millimeter-GaN-Fertigung werden wir unseren Kunden höchste Qualität noch schneller liefern können, während wir auf eine Kostenparität für vergleichbare Silizium- und GaN-Produkte zusteuern“, sagt Johannes Schoiswohl, Leiter der GaN-Business-Line bei Infineon. „Fast ein Jahr nach der Ankündigung des Durchbruchs von Infineon bei der 300-Millimeter-GaN-Wafer-Technologie sind wir erfreut, dass unser Übergangsprozess voll im Plan liegt. Die Branche hat die Bedeutung von Infineons GaN-Technologie, die durch die Stärke unserer IDM-Strategie ermöglicht wird, anerkannt.“

Die Fertigungsstrategie von Infineon basiert in erster Linie auf einem IDM-Modell, bei dem das Unternehmen den gesamten Halbleiterfertigungsprozess, von der Entwicklung bis zur Fertigung und zum Verkauf des Endprodukts, besitzt. Die sogenannte In-House-Fertigungsstrategie des Unternehmens ist ein wichtiger Unterschied im Markt, der Vorteile wie eine hohe Qualität, schnellere Produkteinführung sowie eine einzigartige Design- und Entwicklungsflexibilität bietet. Infineon hat das klare Ziel, seine GaN-Kunden zu

Public / Für die Wirtschafts- und Fachpresse
Informationsnummer INFXX202507-122d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Michael Burner
+49 89 234 39300
michael.burner@infineon.com

Investor Relations:
+49 89 234 26655
investor.relations@infineon.com

unterstützen und kann die Kapazitäten für aktuelle Kundenbedürfnisse nach zuverlässigen und hochwertigen GaN-Leistungsprodukten bereitstellen.

Aufbauend auf seiner technologischen Führungsposition ist Infineon der erste Halbleiterhersteller, der erfolgreich Leistungswafer-Technologie auf einer Größe von 300 Millimetern innerhalb seiner bestehenden Hochvolumen-Fertigungsinfrastruktur entwickelt hat. Die Chip-Produktion auf 300-Millimeter-Wafern ist technisch fortgeschrittener und wesentlich effizienter als auf etablierten 200-Millimeter-Wafern. Der größere Waferdurchmesser ermöglicht es, 2,3-mal mehr Chips pro Wafer zu produzieren. Dieses Know-How in Kombination mit Infineons herausragendem Team von GaN-Experten und dem breitesten IP-Portfolio der Branche sind erforderlich, da GaN-Leistungshalbleiter vermehrt in industriellen und automobilen Anwendungen eingesetzt werden. Zu den weiteren GaN-Zielapplikationen gehören Verbraucher-, Rechen- und Kommunikationsanwendungen wie Stromversorgungen für KI-Systeme, Solarwechselrichter, Ladegeräte und Adapter oder Motorsteuerungssysteme.

Marktanalysten erwarten, dass der GaN-Umsatz für Leistungsanwendungen bis 2030 um 36 Prozent pro Jahr auf etwa 2,5 Milliarden US-Dollar steigen wird[1]. Infineons dedizierte Fertigungskapazitäten und ein starkes Portfolio mit mehr als 40 neuen GaN-Produktankündigungen im letzten Jahr, machen das Unternehmen zu einem bevorzugten Partner für Kunden, die nach hochwertigen GaN-Lösungen suchen.

Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com
Diese Presseinformation finden Sie online unter www.infineon.com/presse
Follow us: X - Facebook - LinkedIn

[1] *Yole Group; Power SiC and GaN Compound Semiconductor Market Monitor, Q2 2025*

Public / Für die Wirtschafts- und Fachpresse
Informationsnummer INFXX202507-122d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Michael Burner
+49 89 234 39300
michael.burner@infineon.com

Investor Relations:
+49 89 234 26655
investor.relations@infineon.com